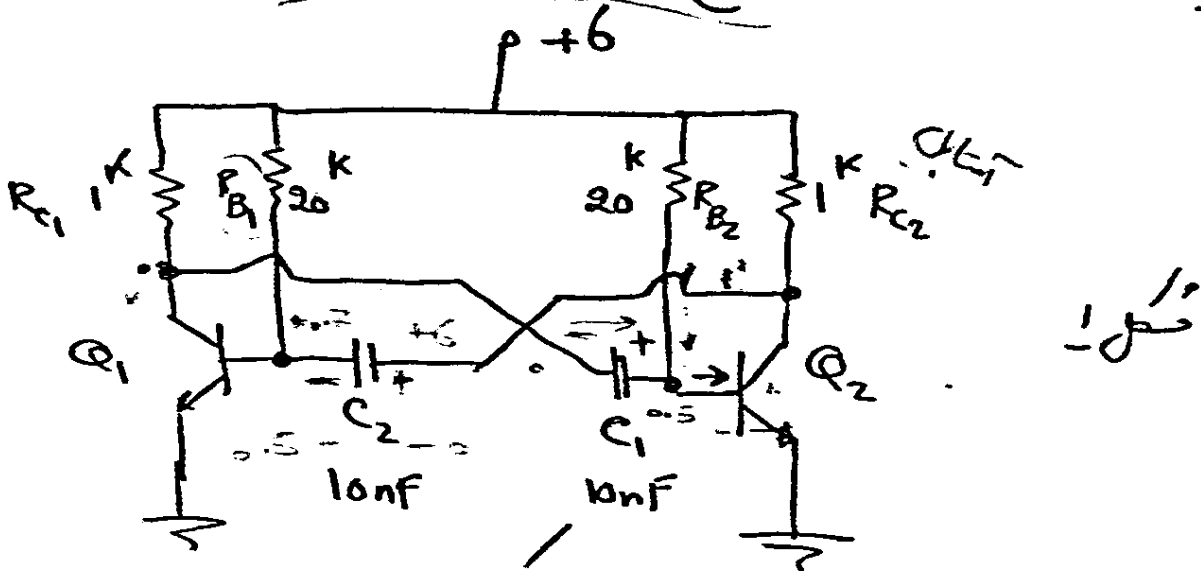
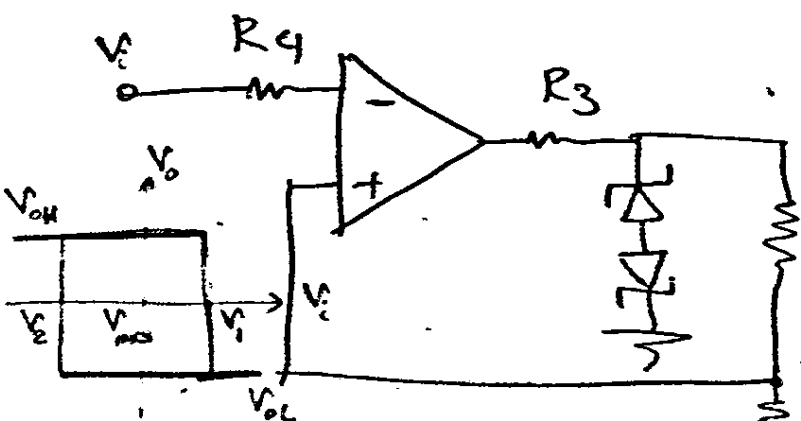


1- مدتی پراکنده زیر را تمییز نموده و شرح دهید. تفاوت اصلی را هم بنویسید.



برای تغییر زمان این مدتی پراکنده در این مدار می‌توانیم از تغییر ظرفیت خازن‌ها استفاده کنیم. اگر در یک نقطه مدل خود را قرار می‌دهیم و فاصله‌ها را مشخص می‌کنیم.

2- مدار استیج زیر را بزرگنمایی کنید و شرح دهید و مشخصه‌های خروجی آن را رسم کنید. در صورت تغییر دما و ولتاژ  $V_R$  نیز توضیح انجام شود.



$$V_+ > V^- \rightarrow V_0 = V^+ = V_2 + V_0$$

$$V^- > V^+ \rightarrow V_0 = -V^- = -(V_2 + V_0)$$

$$V_{mid} = V_{REF} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

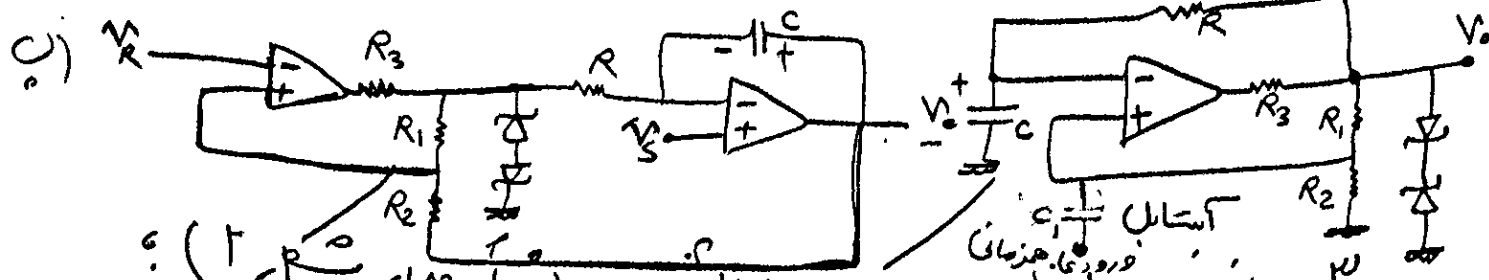
$$V_H = V_1 - V_2 = \frac{2R_2}{R_1 + R_2} (V_0 + V_2)$$

1)  $V_+ > V^-$

$$V_1 = V^- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V^+ + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF}$$

2)  $V^- > V^+$

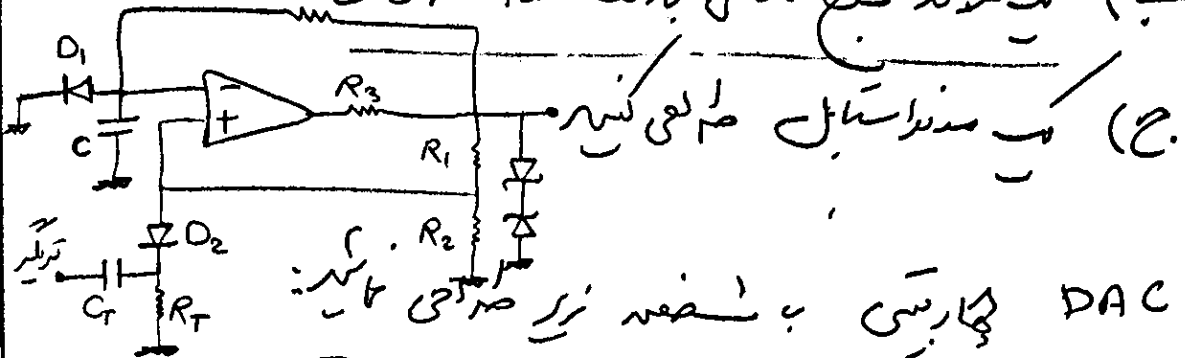
$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V^-) + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{REF}$$



با فرض در اختیار بودن یک مدار استیج (مثلا مدار شکل ۲) ؟

طراحی یک مدتی دیگر استیج استیج (منو دیالوگ) طراحی کنید

یک مدار مع سستی با وقت ضد طراحی کنید R



ج) یک مدار استیج طراحی کنید

۵X - یک DAC چهار بیتی با نصف زیر صحتی

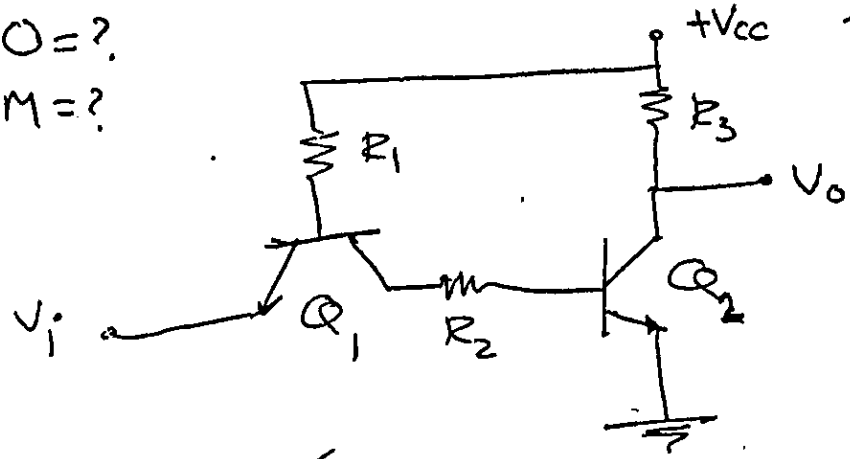
$$V_{out} = \frac{\#D_{in}}{1} \cdot 0.5V$$

#D<sub>in</sub> : عدد بیتی ورودی DAC

(Low) 0 : 0V  
(High) 1 : 5V

FO = ?  
NM = ?

۵X - مدار زیر را تحلیل کنید

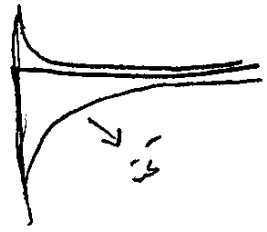


R<sub>1</sub> = 27 K  
R<sub>2</sub> = 3 K  
R<sub>3</sub> = 1 K  
V<sub>cc</sub> = 6  
β = 40  
β<sub>1</sub> = 200

دو عدد در جدول با بار ظاهری 100nF در خروجی تحلیل کنید

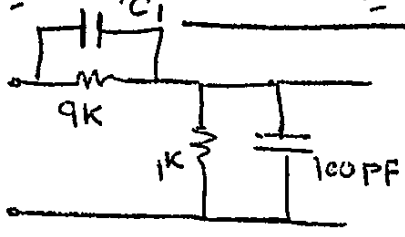
نتیجه  
سحب

لم العمد  
مدون رقم مکتوب بناس



۱- در مدار شکل، برای تعیین مقدار زمان سیم و حذف اثر خارجی بار، مدار را در حالت مدار را در حالت بار قرار دهید.

X در صورت وجود یک کپاسیتانس ۱۰٪ در کمترین مقدار بار، مقدار خروجی را در حالت بار قرار دهید.

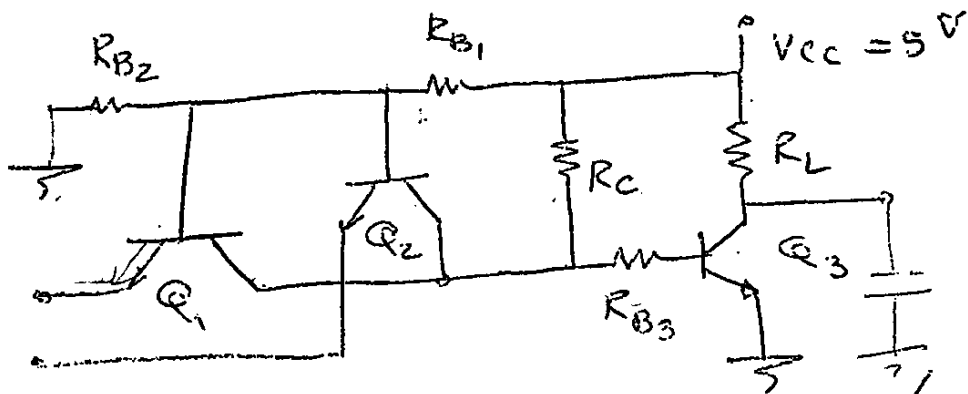


$$R_1 C_1 = R_2 C_2$$

$$C_1 = \frac{100 \text{ pF} \times 1 \text{ K}}{9 \text{ K}} = \frac{100}{9} \text{ pF}$$

Handwritten calculations and notes on the right side of the page, including  $\frac{100}{9} \times \frac{10^{-12}}{10^{-9}}$  and other scribbles.

۲- یک دیود نیم رسانا در مدار یک DAC کوانتیزاسیون ۳ بیتی قرار دارد. این DAC چگونه می تواند یک DAC ۵ بیتی ساخت؟



$\beta = 20$   
 $R_{B2} = 1 \text{ K}$   
 $R_C = 10 \text{ K}$   
 $R_L = 2 \text{ K}$   
 $R_{B1} = 9 \text{ K}$   
 $R_{B3} = 10 \text{ K}$

۳- برای مدار شکل فوق مدار (NM) و (FC) را به همراه تحلیل عملکرد آن در حالت بار قرار دهید.  
 - با فرض وجود یک بار خارجی، مقدار خروجی را در حالت بار قرار دهید.

X ۴- یک دیود نیم رسانا در مدار یک ADC از نوع پلاریت قرار دارد. این مدار چگونه می تواند یک DAC ۵ بیتی ساخت؟

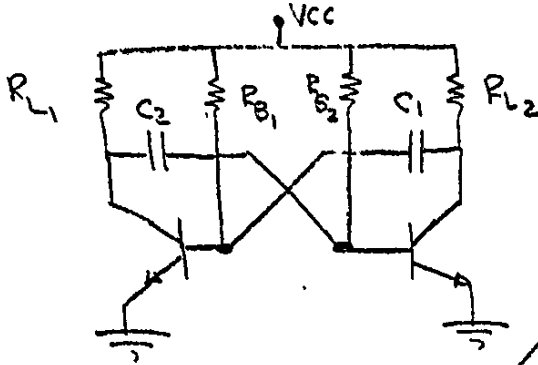


بسمه تعالی

دانشکده فنی و مهندسی

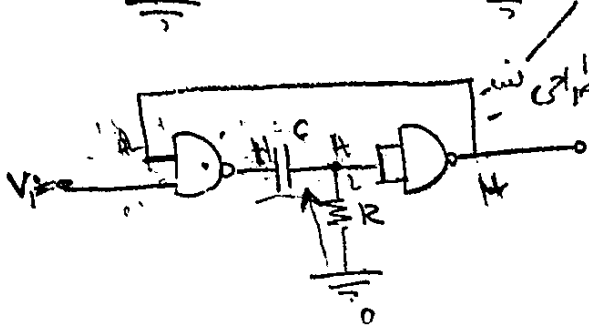
امتحان پایان ترم درس: تکنیک پالس نیمسال: ۸۹۱ تاریخ امتحان: ۸۹/۱/۲۶ نام استاد درس: دکتر ساجدی نیاز به پاسخنامه: دارد □ ندارد □ ماشین حساب: مجاز □ غیرمجاز □ جزوه: باز □ بسته □ زمان پاسخگویی به سوالات تشریحی: دقیقه - تستی: دقیقه - جمع: ۱۲۰ دقیقه

تحویل برگه سوالات در پایان امتحان الزامی می باشد □ الزامی نمی باشد □ استفاده از برگ حاوی فرمول های مرتبط: مجاز □ غیرمجاز □



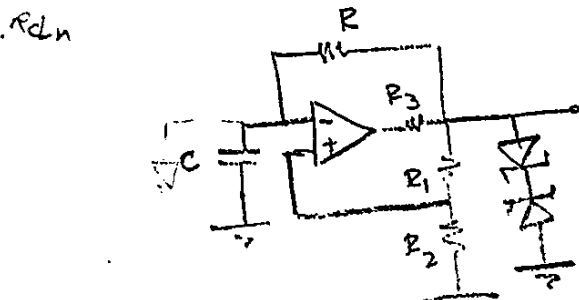
۱- مدار مثل زیر را تحلیل کنید

$R_{B1} = R_{B2} = 20k$   
 $R_{L1} = R_{L2} = 1k$   
 $V_{CC} = 6V$   $C_1 = C_2 = 100nF$



۲- مدار مثل زیر را برای  $T = 100\mu s$  طراحی کنید

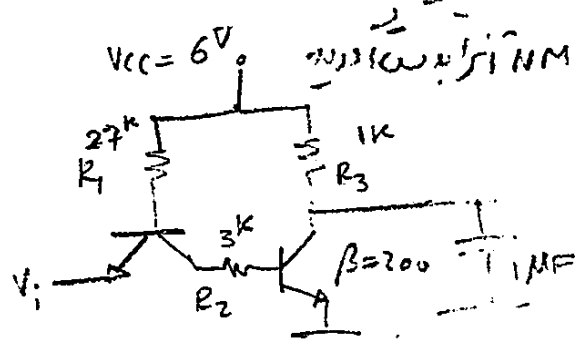
$V_L = V_H = V_T = \frac{V_{CC}}{2}$



۳- مدار مثل زیر را تحلیل کنید و برای مقادیر زیر طراحی کنید

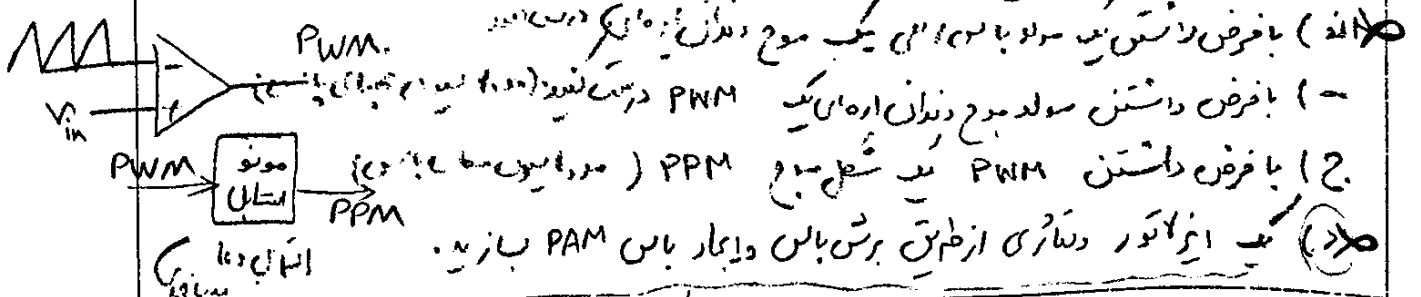
$T_1 = T_2 = 0.5ms$

$T = RC \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}$

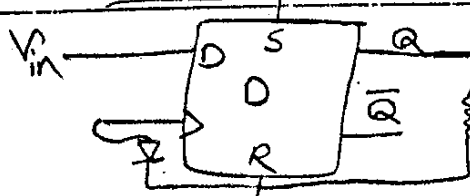


۴- مقادیر مثل زیر را تحسین و FO و NM از این مدار بدست آورید  
مقدار سوئیچینگ برای بار خازنی (شیراکنه) کنید

۵- شکل موج های زیر را ترسیم کنید



$\frac{5 \times 10^{-4}}{10^{-7}} = 5 \times 10^3$

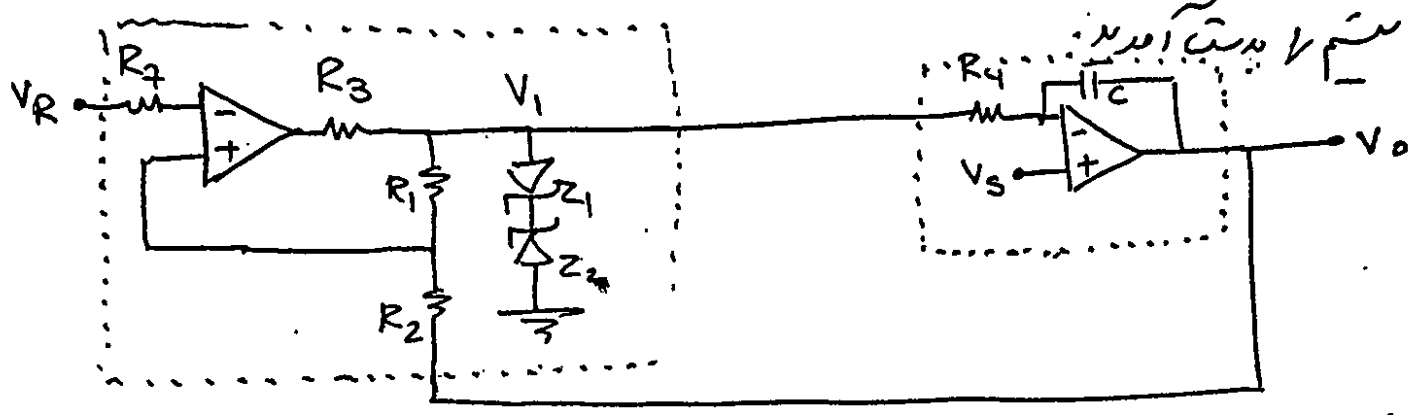


۱- یک DAC چهار بیتی طراحی کنید که در آن توانایی مقادیر مثبت و منفی داشته باشد.

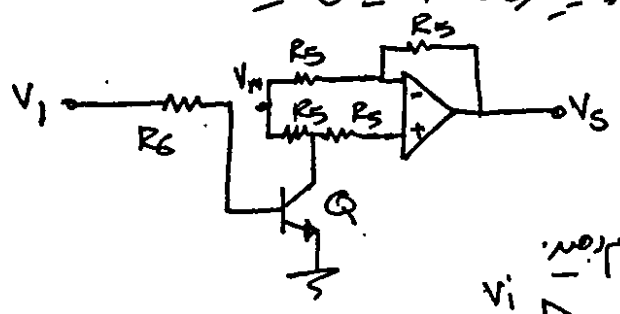
$$V_{out} = [2^V] [(D_3)(2^3) + D_2(2^2) + D_1(2^1) + D_0(2^0)]$$

با فرض در اختیار داشتن تراشه DAC چهار بیتی و تعداد کدهای کدگذاری توان DAC هشت بیتی

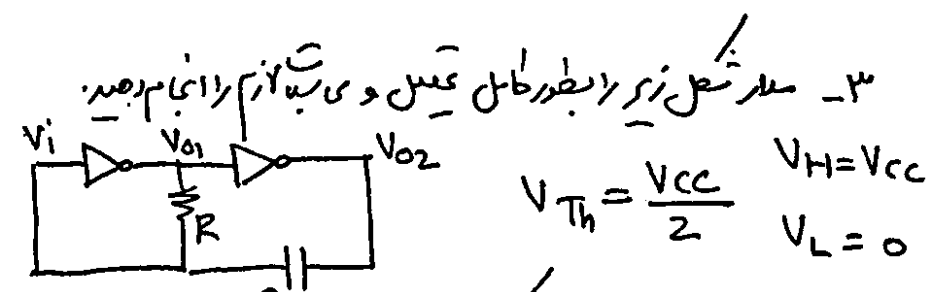
۲- مدارشکل زیر را با تحلیل بخش‌های مختلف رسم  $V_1$  و  $V_0$  شرح کنید. پر بودن نوسان



اگر  $V_S$  به خروجی مدار زیر متصل گردد رفتار چه تغییری می‌کند؟ تحلیل کنید.

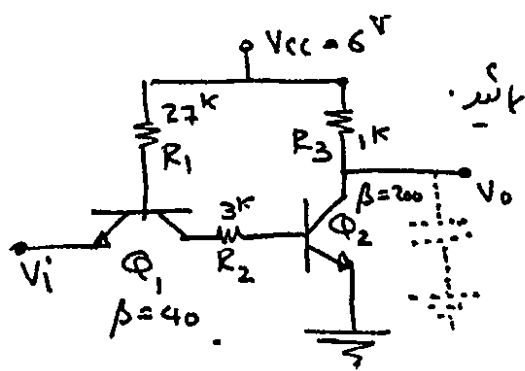
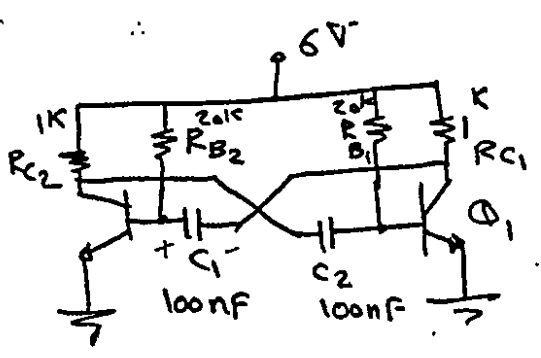


(فرض اشباع  $\phi$  برقرار است)



$$V_{Th} = \frac{V_{CC}}{2} \quad V_H = V_{CC} \quad V_L = 0$$

۴- مدار موتسی و میسر اندر شکل مقابل را تحلیل کنید.



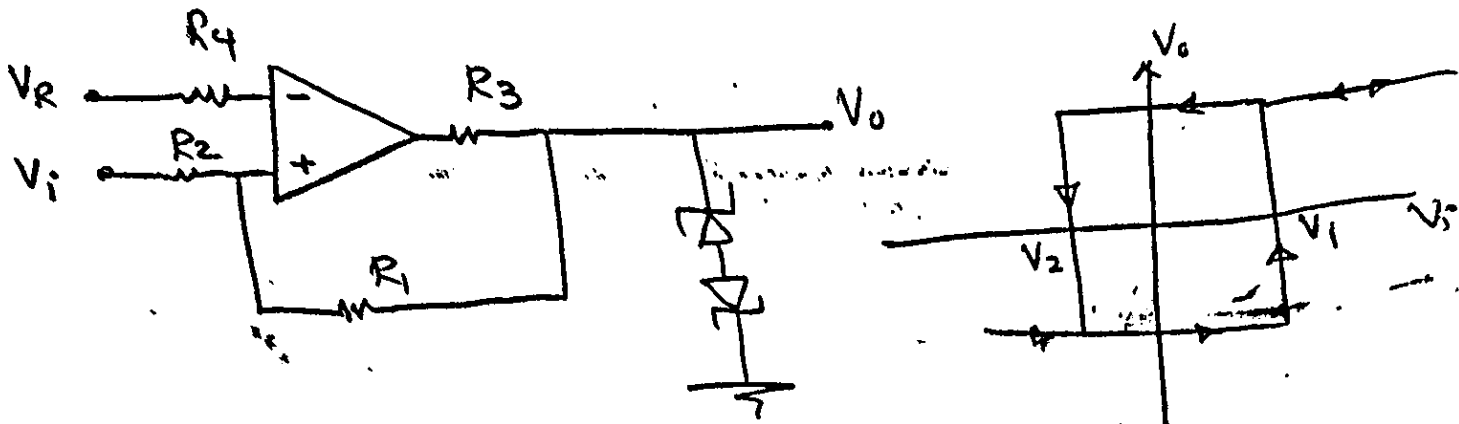
۵- مدار مقابل را تحلیل کنید.

رفتار نویسینگ برای یک بار خازنی  $1\mu F$  را تحلیل کنید.

$$\left\{ \begin{array}{l} FO = ? \\ NM = ? \end{array} \right.$$

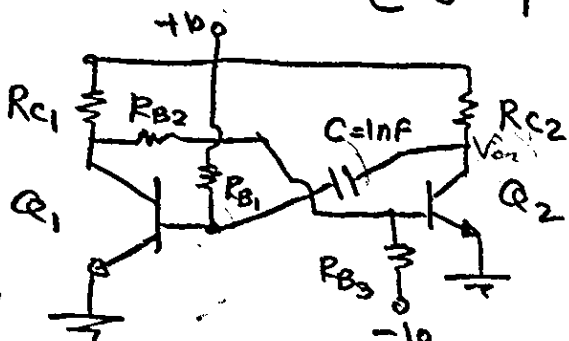
این‌ها دعا  $C_{NL}$

۱- مدار اشیبیت زیر را بطور کامل تحلیل نمایید. مدارهای  $V_1$  و  $V_2$  را بدست آورید.

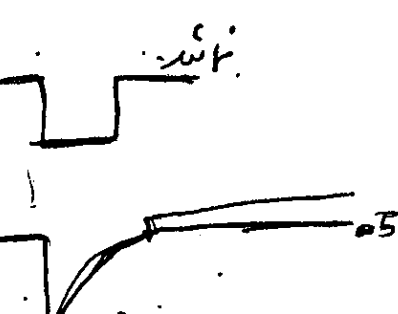


نمودی کنید که تغییر دینارهای زیر و دینار  $V_R$  چه تأثیری دارند.

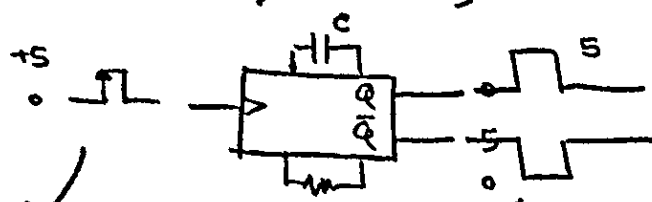
۲- مدار موفراستابل زیر را باص سادات رسم شکل مربع Collector, Base ترانزیستورهای تحلیل



شرطی  
 $R_{C1} = R_{C2} = 1k$   
 $R_{B1} = R_{B2} = 20k$   
 $R_{B3} = 80k$

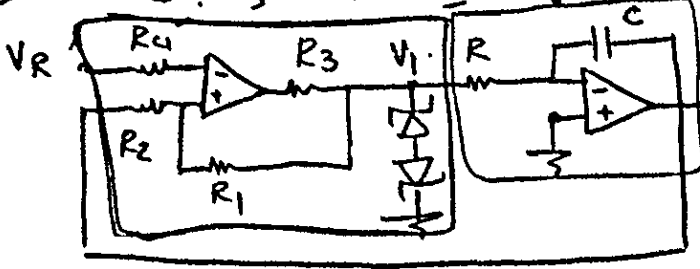


۳- با فرض که اضاچار داشتن یک موفراستابل (به تعداد لازم) بصورت زیر آید می‌توانید یک استابل (مولد مربع مربع) تولید کنید بجهای پالسن این مولد در سلسله ترانزیستور استابل در خواش از میدنه حال تغییر است



بجهای این مولد است  $T = 0.7 * RC$

۴- با فرض که اضاچار داشتن مقاربت‌های باقت // یک DAC چهاربیتی طراحی کنید  
۵- مدار زیر را تحلیل کنید



$V_o = ?$   $V_i = ?$

موفق باشید  
س.ص